PCT

国際予備審查報告

REC'D 0 1 JUL 2004

| VIPO: | PC, | Ţ |
|-------|---------|---|
| | | |

(法第12条、法施行規則第56条). [PCT36条及びPCT規則70]

| 出願人又は代理人 の審類記号 03NPCT002 | 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。 | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 国際出願番号 PCT/JP03/12080 | 国際出願日 (日.月.年) 22.09.03 優先日 (日.月.年) 09.12.02 | | | | | | |
| 国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L21/3205, H01L21/28 | | | | | | | |
| 出願人(氏名又は名称) 日本電気株式会社 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1. 国際予備審査機関が作成したこの国 | 国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。 | | | | | | |
| 2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。 | | | | | | | |
| X この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で 3 ページである。 | | | | | | | |
| 3. この国際予備審査報告は、次の内容 | 3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 | | | | | | |
| I X 国際予備審査報告の基礎 | I X 国際予備審査報告の基礎 | | | | | | |
| Ⅱ □ 優先権 | | | | | | | |
| Ⅲ Ⅲ 新規性、進歩性又は産業 | 上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 | | | | | | |
| IV 発明の単一性の欠如 | | | | | | | |
| V X PCT35条(2)に規定す の文献及び説明 | る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため | | | | | | |
| VI | | | | | | | |
| VII 国際出顧の不備 | | | | | | | |
| WI 国際出願に対する意見 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| · | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 国際予備審査の請求書を受理した日 22.09.2003 | 国際予備審査報告を作成した日 03.06.2004 | | | | | | |
| AT THE TO WAS IN THE | | | | | | | |

| | I. 国際予備審査報告の基礎 | |
|------------|---|---|
| | 1. この国際予備審査報告は下記の出願番類に基づいて作成され 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書にお P.C T規則70.16,70.17) | た。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に いて「出願時」とし、本報告書には添付しない。 |
| | 出願時の国際出願書類 | |
| | X 明細書 第 1-30 ページ、」 明細書 第 ページ、」 明細書 第 ページ、 | 出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の番簡と共に提出されたもの |
| | X 請求の範囲 第 | 出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求審と共に提出されたもの |
| | X 図面 第 1-17 ページ/図、日 図面 第 ページ/図、日 図面 第 ページ/図、日 | 出題時に提出されたもの 国際予備審査の請求象と共に掲出されたもの |
| | 明細費の配列表の部分 第 ページ、出明細費の配列表の部分 第 ページ、国明細費の配列表の部分 第 ページ、国明細費の配列表の部分 第 ページ、 | 出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの |
| | 2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国上記の書類は、下記の言語である | 駅文の言語 |
| 3 | □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または5 3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出さ □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出さ □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際書の提出があった □ 書の提出があった □ 皆面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配があった。 | 、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 |
| 4 . | 補正により、下記の書類が削除された。 | |
| | | |

| V. | 新規性、進歩性又は産業上の利用 文献及び説明 | 可能性についての法第12条 | (PCT35条(2)) に定める見解、 | それを裏付ける |
|----|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| 1. | 見解 | | | |
| Ŕ | 所規性(N) | 請求の範囲 | 1-6, 8, 13, 15 7, 9-12, 14, 16, 17 | |
| ĭ | 基歩性(IS) | 請求の範囲 | <u>1, 4, 8, 1</u> 3, 15 | 有 |

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲 2,3,5-7,9-12,14,16,17 無 請求の範囲 1,17

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 2-165632 A (株式会社東芝) 1990.06.26

請求の範囲

文献 2: EP 751567 A 2 (International Business Machines Corporation) 1997.01.02

文献3: JP 11-102909 A (ソニー株式会社) 1999.04.13

請求の範囲2,3,5,6に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1(全文,第1-3図)により進歩性を有しない。

文献1により教示された配線用銅合金において、形成予定の配線の幅、厚さ、必要とする抵抗値、エレクトロマイグレーション耐性等を考慮して、結晶粒内部の添加元素の濃度を最適化して0.1原子%以下とすることは、当業者にとって容易である。

請求の範囲2,5,6に係る発明は、国際調査報告で引用された文献2(全文,第1-11図)により進歩性を有しない。 文献2により教示された配線用銅合金において、形成予定の配線の幅、厚さ、必要とする抵抗値、エレクトロマイグレーション耐性等を考慮して、結晶粒内部の添加元素の濃度を最適化して0.1原子%以下とすることは、当業者にとって容易である。

請求の範囲 7, 9-12, 14, 16に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 3 (全文,第1-6図) に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲17に係る発明は、国際調査報告で引用された文献2(全文,第1-1 1図)に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲1,4,8,13,15に係る発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

請求の範囲

1. (補正後) Cu(銅) を主成分とし、添加元素を含有する多結晶銅合金からなり、

- 2. (補正後) 前記添加元素が、Ti (チタン)、Zr (ジルコニウム)、Hf (ハフニウム)、Cr (クロム)、Co (コバルト)、A1 (アルミニウム)、Sn (
- 10 錫)、N i(ニッケル)、M g(マグネシウム)及びA g(銀)からなる群から選択された少なくとも1 種の元素であることを特徴とする請求項1 <u>又は5</u>に記載の配線用銅合金。
 - 3. (補正後) 前記結晶粒界及び/又は前記結晶粒界近傍には、Ti、Zr、Hf、Cr、Co、Al、Sn、Ni、Mg及びAgからなる群から選択された少なくとも1種の元素とCuとの金属間化合物が形成されていることを特徴とする請求項5に記載の配線用細合金

15

20

25

- 4. (補正後) 前記結晶粒界及び/又は前記結晶粒界近傍には、Ti、Zr、Hf、Cr、Co、Al、Sn、Ni 、Mg及びAgからなる群から選択された少なくとも1種の元素の酸化物が形成されていることを特徴とする請求項5に記載の配線用銅合金。
- 5. (補正後) Cu (銅) を主成分とし、添加元素を含有する多結晶銅合金からなり、

前記添加元素の濃度が、前記多結晶銅合金を構成する結晶粒の結晶粒界及び結晶粒界近傍において、前記結晶粒の内部よりも高く、前記結晶粒内部の前記添加元素の濃度が 0.1原子%以下であることを特徴とする配線用銅合金。

6. (補正後) 半導体素子が形成された基板上に、請求項1乃至5<u>17</u>のいず

れか1項に記載の配線用銅合金からなる金属配線が形成されていることを特徴と する半導体装置。

7. 多結晶Cu膜を形成する工程と、

前記多結晶Cu膜上に、前記Cu膜中への添加元素からなる層を形成する工程 5 と、

- 17. (追加) <u>Cu (銅) を主成分とし、添加元素を含有する多結晶銅合金からなり、</u>
- 前記添加元素の濃度が、前記多結晶銅合金を構成する結晶粒の結晶粒界及び結晶粒界近傍において、前記結晶粒の内部よりも高く、更に、周囲にバリア層が形成されており、前記バリア層との界面及び界面近傍において、前記添加元素の濃度が前記結晶粒の内部よりも高くなっていることを特徴とする配線用銅合金。